⑰日本国特許庁(JP)

砂特許出願公開

@公開特許公報(A)

昭63-67762

@Int_CI_4

證別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和63年(1988)3月26日

H 01 L 23/50 23/28 G-7735-5F A-6835-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

樹脂封止半導体装置用リードフレーム

②特 関 昭61-212196

60出 頤 昭61(1986)9月9日

砂発明者 濱野

清 治

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

60出 顋 人 富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

砂代 理 人 弁理士 井桁 貞一

明 紀 事

-1. 発明の名称

樹脂封止半導体装置用リードフレーム

2. 特許請求の範囲

- 1) 封止樹脂と接する面に粗化加工面が設けられてなることを特徴とする樹脂封止半導体装置用リードフレーム。
- 2) 上記相化加工面は、表面を製地状にする化学エッチングにより形成されたものであることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の樹脂封止 半導体装置用リードフレーム。

3. 発明の詳細な説明

(概要)

樹脂封止半導体装置に用いるリードフレームに おいて、

封止樹脂と接する面に穏化加工面を設けること により、

封止樹脂との接合独皮を高め、半導体装置にお

ける耐湿性の劣化を防止したものである。

(産業上の利用分野)

本発明は、樹脂封止半導体装置用リードフレームに係り、特に、半導体装置の耐湿性を高めるための構成に関す。

半導体装置では、リードフレームを用いた樹脂 封止が多用されるようになって来たが、この場合、 リードフレームと封止樹脂との接合部を遠した水 分の侵入による信頼性の低下を抑えることが重要 である。

〔逆来の技術〕

樹脂封止半導体装置用リードフレームの従来例は、第3回の平面関に示すが知くである。

同図に示すリードフレームは、厚さ 0.2 m 相 皮 の 表面が平滑な快系または網系などの金属板から なる金属条 1 から、チップパッド 2 、インナリード 3 、アウタリード 4 、タイパー 5 など以外の部分を除去して形成されたパターンが複数組並んだ

ものであり、インナリード3の先娘部およびチャ アパッド2には、金などのめっきが絶されている。 このパターンの形成は、アレス加工またはエッチ ング加工によってなされている。

このリードフレームを用いた樹脂封止半導体装置は、例えば第4回の側断面図に示すが如くである。

同図に示す半導体装置は、無積塑路の形成された半導体チップ 6 が、チップパッド 2 に固定にチップボンディング) されワイヤ 7 によりインナードの先端部と接続(ワイヤボンディング)された後、針止樹脂 8 により封止(樹脂成形)されてなっている。なお樹脂成形の後、リードフレームの麦出部はめっきが能され、不要部であるタイプ・5 中金属条1 の高辺などは切断除去され、ワウタリード 4 は所定の形状に成形されている。

封止樹脂 8 はインナリード 3 から内側を完全に 週めているので、この半導体装置は、半導体チップ 6 が封止樹脂 8 により外界の環境から保護され ている。 しかしながら、上記のリードフレームを用いた 半導体装置では、インナリード3の表面が平滑で あるため、インナリード3と封止樹脂8との接合 部が両者の無態張係数の差に起因する応力によっ てスリップし、そこに銅粒が発生する場合がある。

そしてこの制能の発生は、外界の水分の侵入を 許すことになり、耐湿性の劣化による信頼性の低 下を招く問題となる。

上記問題を解決するためには、インナリード3と対止樹脂8との役合部がスリップしないように、質者間の役合強度を高めてやれば良い。

これを実現するものとして、インナリード3を 第5回の部分斜視図に示す3aの如くに改良したリ ードフレームがある。

即ちィンナリード3aには、曲げ9aや切欠き9bが 扱けられている。この曲げ9aや切欠き9bは、封止 樹脂 8 と哈み合ってインナリード3aと封止樹脂 8 との間の接合強度を高め、接合部がスリップする のを防止している。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、曲げ9a や切欠き9bを設けることは、リードフレームの製造設備例えばプレス型などの構成を複雑にしてリードフレームの製造コストを高め、然も半導体整定の高気積化に伴い数組化傾向にあるインナリード3aの形状寸法により制約されて実現限数な場合がある。

(問題点を解決するための手段)

上記問題点は、針止樹脂と接する面に根化加工 面が設けられてなる本発明のリードフレームを用 いることによって解決される。

本発明によれば、上記額化加工面は、要面を製 地状にする化学エッチングにより形成されたもので であるのが望ましい。

(作用)

本リードフレームは、封止制限と捜する面即ち インナリードの表面に製造状の相化加工面即ち級 小凹凸の形成された面が設けられており、この凹 凸が封止樹脂と喰み合うので、第5図で説明した曲げ9aや切欠き9bが設けられなくとも、インナリードと封止樹脂との間の接合強度が高くなり、両者の授合部がスリップするのを防止する。

そして製造においては、曲げ9m や切欠き9bが不 製であることから、インナリードの形状寸法に制 約されることなく実現可能であり、然も、エッチ ング工程の追加を必要とするものの、リードフレ ームの製造設備例えばプレス型などの構成を複雑 にすることがないので、問題にするようなコスト 高にはならない。

(実施例)

以下、本発明によるリードフレームの実施例に ついて第1図および第2図を用い説明する。

第1 図は第3 図図示従来例に相当する実施例の平面図、第2 図は実施例の相化加工面を設別する部分側面図である。全図を通じ同一符号は同一対象物を示す。

第1図に示すリードフレームは、第3図図示従

条例のインナリード3をその裏面(図の上下面) が親化加工で10となったインナリード3bに変えた ものである。

即ちこのリードフレームは、第3回で説明したプレス加工またはエッチング加工によるパターンの形成の後、表面を製地状にする化学エッチングの工程が追加されて粗化加工面10が形成され、その後、インナリード3bの先端部およびチップパッド2に会などのめっきが能されたものである。

粗化加工面10を形成する上記化学エッチングは、全国条1の材料が快系の場合には、硝酸・頻酸水溶液をたは硝酸・磺酸水溶液を、また網系の場合には、クロム酸・硫酸水溶液をエッチング液にした孔金エッチングであり、エッチング液では1~3μα 程度である。そしてエッチング後の表面である。それでエッチング後の表面である。10の表面は、第2回に示す如く後小回凸11の形成された面となる。

このリードフレームを用いた樹脂封止半導体装置の製造は、第4図で説明したのと同様である。

かく製造された半導体整置では、封止樹脂8が

粗化加工而10の凹凸にと紹う合うので、インナリード3bと封止損額8との間の接合強度が高くなり、 両者間のスリップによる割離の発生が防止される。 従って、耐湿性の劣化による信頼性の低下が抑え られる。

なお相化加工面10の領域は、上記実施例ではイ ンナリード3bの全長となっているが、その一部で あっても針止樹脂 8 との間のスリップ防止の作用 を果たすこと、また逆にアウタリード 4 の観囲ま で広がっても支端のないことは容易に理解出来る。

また、権化加工面10の形象は、実施例では上記化学エッチングによって行い表而に残留応力の残らないようにしたが、機械的方法例えばサンドブラストなどによって行っても上記スリップ防止の作用を果たすことは容易に領推出来る。

(発明の効果)

以上説明したように本発明の構成によれば、樹 脂封止半導体装置に用いるリードフレームにおい て、インナリードの形状寸法に制約されることな

く封止樹脂との複合強度を高めることが高コスト にすることなく実現出来で、半導体装置における 耐湿性劣化による信頼性低下を抑える効果がある。

4. 図面の簡単な説明

部1団は本発明実施例の平面図、

第2図は実施例の相化加工面を説明する部分側 面図、

第3回は従来例の平面図、

第4図は樹脂封止半導体装置例の側断面図、

第5回は改良例の部分斜視図、

である.

図において、

1は金銭条、

3、3a、3bはインナリード、

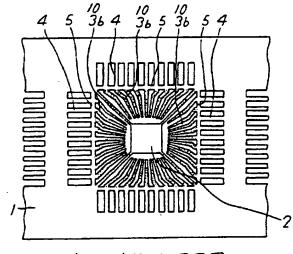
4 はアウタリード、

8 は封止樹廟、

10は親化加工面、

1)は微小凹凸、

てある.

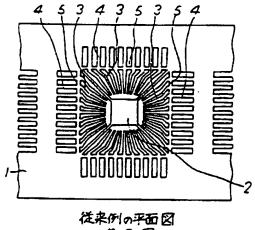


本発明実施例の平面図 芝 1 図

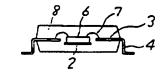
promoting 36

実施例の粗化加工面で説明する部分側面図 差 2 図

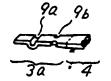
代理人 弁理士 井衍真一



従来例の平面図 第3図



樹脂計止半導体装置例の側断面図 第 4 図



改良例の部分斜視図 第 5 図

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:	
☐ BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.